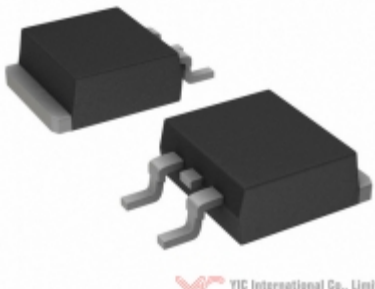









	<p>Référence fabricant: FDB8453LZ</p>
	<p>Fabricant / Marque: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Une partie de la description: MOSFET N-CH 40V 16.1A TO-263AB</p>
	<p>Feuilles de données:  FDB8453LZ.pdf</p>
<p>Statut RoHS: Sans plomb / conforme à la directive RoHS</p>	<p>État du stock: New original, 19645 pcs Stock Available.</p>
<p>Bateau de: Hong Kong</p>	<p>Manière d'expédition: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Caractéristiques

Numéro d'article	FDB8453LZ
Fabricant	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
La description	MOSFET N-CH 40V 16.1A TO-263AB
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors -
État de la pièce	19645 pcs Stock
Description détaillée	N-Channel 40V 16.1A (Ta), 50A (Tc) 3.1W (Ta), 66W
Séries	PowerTrench®
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Température de fonctionnement	-55°C ~ 150°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Package / Boîte	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Package composant fournisseur	TO-263AB
Dissipation de puissance (max)	3.1W (Ta), 66W (Tc)
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	40V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	16.1A (Ta), 50A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 17.6A, 10V
Vgs (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	66nC @ 10V
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	3545pF @ 20V
Tension d'entraînement (Max Rds activé, Min Rds	4.5V..10V
Vgs (Max)	±20V
Emballage	Original-Reel®
Statut sans plomb / Statut RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	1 (Unlimited)
Autres noms	FDB8453LZDKR

FDB8453LZ est un nouvel original en stock, recherchez des fiches techniques FDB8453LZ, PDF, inventaire chez Y-IC.com en ligne, commandez FDB8453LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor avec garantie et confiance. RFQ FDB8453LZ: Info@Y-IC.com

Vous pourriez aussi être intéressé par:

 <p>FDB86360 FAIRCHI FDB86360 FAIRCHI</p>	 <p>FDB86135 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V D2PAK</p>	 <p>FDB8447L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 15A D2PAK</p>	 <p>FDB86135 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V D2PAK</p>
 <p>FDB86102LZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 30A D2PAK</p>	 <p>FDB86102LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 30A D2PAK</p>	 <p>FDB8447L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 15A D2PAK</p>	 <p>FDB8445_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 70A D2PAK</p>

Hot Pièces

Plus

FDB6670BL	FDB6670S	FDB6670S-NL	FDB6676S	FDB6690S
FDB6690S	FDB66N15TM	FDB7030BL	FDB7030BL	FDB7030BLS
FDB7030L	FDB7030L	FDB7042L	FDB7045L	FDB8030L
FDB8030L	FDB8132_F085	FDB8132_F085	FDB8160_F085	FDB8441_F085
FDB8442_F085	FDB8443_F085	FDB8444TS	FDB8444TS	FDB8444_F085
FDB8447L	FDB8447L	FDB8453LZ	FDB86102LZ	FDB86102LZ
FDB86135	FDB86135	FDB86360	FDB86363	FDB86363_F085
FDB86366	FDB86366_F085	FDB86563	FDB8832_F085	FDB8860_F085
FDB8880-NL	FDB8880-NL	FDB8880TM	FDB8896_F085	FDB9403_F085
FDB9406_F085	FDBL86210-F085	FDBS09H04	FDBS09H04	FDBS09H04

Contact us:Info@Y-IC.com

AJOUTER: Unité A5-B5 n ° 509, 5 / F, bâtiment de l'usine de Win Win, 15-17 rue Shing yip, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Droits d'auteur © 2019 YIC International Co., Limited